

## ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ КОНВЕКЦИИ

© Б.Л.Сморodin, В.С.Шавкунов

Термоэлектрическое поле в неоднородно нагретых жидких полупроводниках может приводить к неустойчивости равновесия и возникновению движения [1]. Стационарная конвекция в расплавах полупроводников, обусловленная термоэлектрическим механизмом, подробно изучена [2-4]. В условиях невесомости рэлеевский механизм неустойчивости не работает и неустойчивость может быть вызвана появлением термо-ЭДС. Проблема подавления конвекции, приводящей к переносу примеси, тесно связана с получением высокочистых образцов полупроводников. В [5] исследовано воздействие вибраций на термоэлектрическую конвекцию. Существует и другой механизм динамического воздействия на устойчивость равновесия жидкого полупроводника: параметрическое изменение температуры на его поверхности.

В настоящей работе исследовано влияние модуляции равновесного вертикального градиента температуры на конвекцию термо-ЭДС в горизонтальном слое жидкого полупроводника со свободными изотермическими границами. Рассматриваются такие частоты модуляции температуры  $\omega_0$ , при которых толщина слоя  $h$  много меньше глубины проникновения тепловой волны  $\delta = (\chi/\omega_0)^{1/2}$ ,  $\chi$  — температуропроводность жидкости. С другой стороны, предполагается, что дебаевский радиус много меньше толщины слоя. В этом

случае можно пренебречь пространственной неоднородностью равновесных градиента температуры  $\nabla T_0$  и поля  $E_0$ :

$$\begin{aligned}\nabla T_0 &= -(A + a \sin \omega_0 t) = -A(1 + \eta \sin \omega t), \\ E &= \gamma \nabla T_0 = -\gamma A(1 + \eta \sin \omega_0 t).\end{aligned}\quad (1)$$

Здесь  $A$  — средний градиент температуры,  $a$  — амплитуда,  $\eta$  — относительная амплитуда модуляции градиента температуры,  $\gamma$  — коэффициент термоэлектродвижущей силы.

Безразмерные уравнения, описывающие эволюцию малых возмущений нестационарного равновесия, запишутся в виде

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} &= -\nabla p + \Delta \mathbf{v} + \text{Ra} T \mathbf{e} - B \rho (1 + \eta \sin \Omega t) \mathbf{e}; \quad \mathbf{e} = (0, 0, 1); \\ P \frac{\partial T}{\partial t} - (1 + \eta \sin \Omega t) v_z &= \Delta T; \quad v_z = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}; \\ P_1 \frac{\partial \rho}{\partial t} &= -\rho + \Delta T; \quad \text{div} \mathbf{v} = 0; \\ z = 0, 1; \quad v_z = 0, \quad \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} &= 0; \quad \rho = 0; \quad T = 0,\end{aligned}\quad (2)$$

где  $p$ ,  $\mathbf{v}$ ,  $\rho$ ,  $T$  — возмущения давления, скорости, плотности заряда и температуры;  $\text{Ra} = g\beta Ah^4/\chi\nu$  — число Рэлея;  $B = \varepsilon\gamma^2 A^2 h^2/\rho l \chi \nu$  — термоэлектрический параметр конвекции;  $\text{Pr} = \nu/\chi$ ,  $P_1 = \varepsilon\nu/\sigma h^2$  — тепловое и электрическое числа Прандтля;  $\Omega = \omega_0 h^2/\chi$  — безразмерная частота вибрации ( $\rho l$ ,  $\nu$ ,  $\sigma$ ,  $\varepsilon$ ,  $\beta$  — плотность жидкости, коэффициенты вязкости, электропроводности, диэлектрической проницаемости, теплового расширения,  $g$  — ускорение свободного падения).

Будем считать, что  $P_1 \approx 0$  (избыточный заряд возникает только за счет термодиффузии). Для жидких полупроводников с высоким коэффициентом термо-ЭДС, например Se электропроводность  $\sigma \sim 10^{-4} \text{Om}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$  [6], что для слоев  $h > 1$  мм оправдывает оценку  $P_1 \approx 0$ .

Рассмотрим нормальные возмущения равновесия ( $\mathbf{v}$ ,  $T$ ,  $p$ ,  $\rho$ ) =  $a_i(t) \sin(\pi z) \exp(ik_x x + ik_y y)$ . Здесь  $a_i(t)$  — амплитуды возмущений;  $k_x$ ,  $k_y$  — волновые числа, характеризующие периодичность возмущений в плоскости слоя.

Для амплитуд скорости  $a_1$  и температуры  $a_2$  получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами

$$a_1 + n a_1 = [R' + B'(1 + \eta \sin \omega t)] a_2;$$

$$\begin{aligned} \dot{a}_2 + \frac{1}{n}a_2 &= (1 + \eta \sin \omega t)a_1; \\ R' &= \frac{k^2 Ra}{(k^2 + \pi^2)^3} = \frac{Ra}{Ro}; & B' &= \frac{k^2 B}{(k^2 + \pi^2)^2}; \\ n &= \sqrt{P}; & \omega &= \frac{\Omega}{(k^2 + \pi^2)}. \end{aligned} \quad (3)$$

$B_0, R_0$  — пороговые значения параметров для термоэлектрической [1] и рэлеевской [7] конвекции в статическом случае.

При произвольных значениях параметров  $R', B', \eta, \omega, n$  решение системы (2) либо нарастает, либо затухает со временем. На границе устойчивости решение нейтрально, реализуется периодический режим. Для отыскания границ устойчивости применялся метод характеристических показателей [7-8]. Построение фундаментальной системы осуществлялось численно с помощью интегрирования уравнений (2), методом Рунге-Кутты.

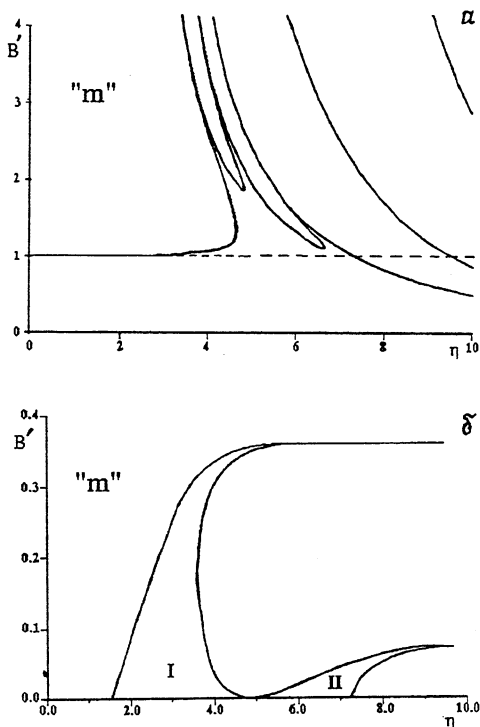


Рис. 1. Карты устойчивости равновесия на плоскости  $(\eta, B')$  при частоте  $\omega = 1$ : а —  $R' = 0.0, n = 1.0$ ; б —  $R' = 1.2, n = 1 + \sqrt{2}$ .

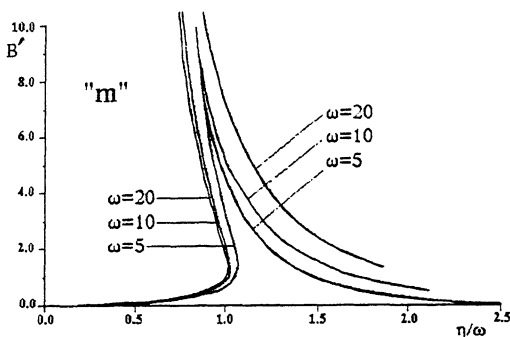


Рис. 2. Области неустойчивости на плоскости параметров  $(\eta/\omega, B')$ .  $R' = 1.2$ ,  $n = 1.0$ .

Результаты расчетов следующие. В невесомости ( $R' = 0$ ) без модуляции температуры равновесие неустойчиво только для  $B' > 1$ . Модуляция температуры приводит к тому, что для  $B' < 1$  появляются области параметрической неустойчивости (рис. 1, а,  $\omega = 1$ ,  $n = 1$ ), а при  $B' > 1$  граница основной полосы "m" с ростом амплитуды  $\eta$  повышается, оставляя область параметрической стабилизации равновесия. При больших амплитудах модуляции  $\eta$  неустойчивость связана с параметрическим резонансом. В соседних областях возмущения имеют разный период: он либо вдвое превосходит период модуляции ("полуцелые" решения), либо совпадает с ним ("целые" решения).

В поле силы тяжести ( $R' \neq 0$ ) ситуация изменяется: первая "полуцелая" область расширяется. Кроме того, в отличие от статического случая, когда при  $R' > 1$  равновесие неустойчиво, модуляция температуры приводит к появлению на карте устойчивости областей стабилизации I, II (рис. 1, б,  $R' = 1.2$ ,  $\omega = 1$ ,  $n = 1 + \sqrt{2}$ ).

Границы устойчивости на плоскости  $(B', \eta/\omega)$  для  $R = 1.2$ ,  $n = 1$  и разных значений частоты  $\omega = 5, 10, 20$  изображены на рис. 2. При увеличении частоты граница основной области неустойчивости сходится к предельной линии, а граница первой резонансной области ("полуцелое" решение) повышается, вытесняясь на бесконечность. Для основной области неустойчивости случай высоких частот наступает при  $\omega \approx 10$ .

#### Список литературы

- [1] Иоффе И.В., Калинин Н.В., Эйдельман Е.Д. // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2. В. 9. С. 395-396.
- [2] Эйдельман Е.Д. // ЖЭТФ. 1993. Т. 103. В. 5. С. 1633-1644.
- [3] Эйдельман Е.Д. // ЖТФ. 1993. Т. 63. В. 10. С. 192-195.

- [4] Саранин В.А. // Магнитная гидродинамика. 1983. № 1. С. 85–89.
- [5] Смородин Б.Л. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В. 21. С. 6–8.
- [6] Катлер Н. Жидкие полупроводники. М., 1980. 256 с.
- [7] Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость не-сжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. 392 с.
- [8] Коддингтон Э.А., Левинсон Н. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. ИИЛ, 1958.

Пермский государственный  
университет

Поступило в Редакцию  
17 октября 1995 г.

